

<b>ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СДВОЕННОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ МОП-РЕЛЕ 60В/50 МА</b>	<b>249КП10АР, 249КП10БР АЕЯР.431160.609 ТУ</b>
<b>МОП 44 001.04-2010 Часть 4 Книга 1 Раздел 1 п. 3.2.11, п. 3.2.12 (стр. 16)</b>	<b>Патент № 100299 от 24.06.2010</b>

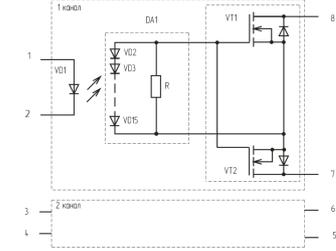
### Особенности

- 2 изолированных канала;
- коммутируемое напряжение  $\pm 60\text{В}$
- коммутируемый ток:  $\pm 50\text{ мА}$
- ток управления 12...25 мА
- малая выходная емкость  $\leq 10\text{ пФ}$
- время включения/выключения: 50 мкс
- 8-выводной металлокерамический корпус типа DIP 2101.8-7.

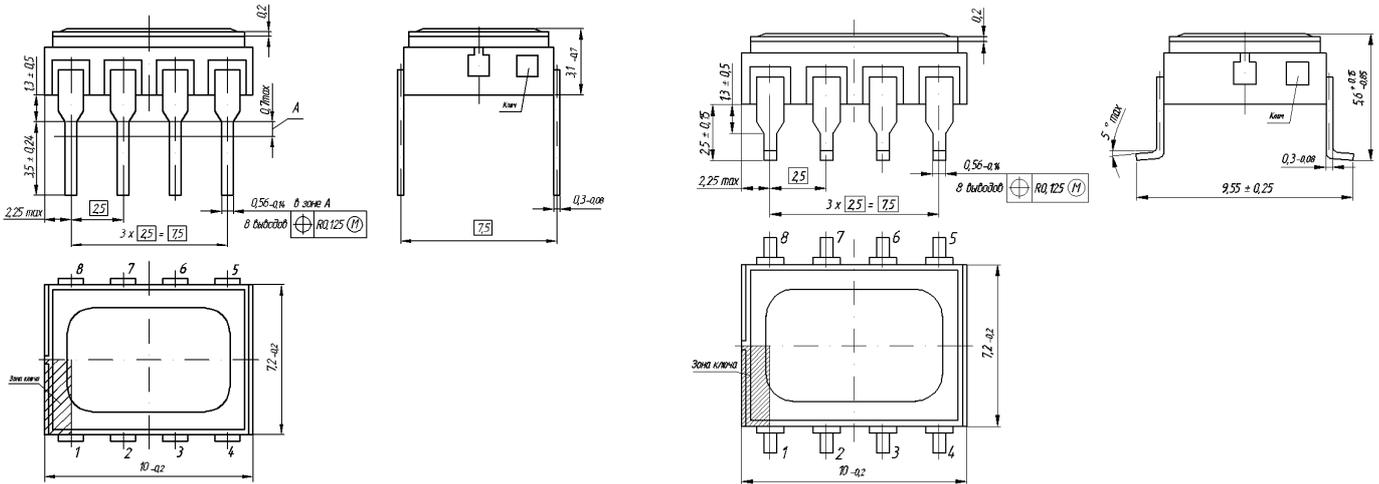
### Применение

- замена электромагнитных реле;
- телекоммуникационная техника;
- аналоговые мультиплексоры.

### Электрическая схема



### Общий вид, габаритные и присоединительные размеры



У80.073.449 ГЧ

УКВД.430109.511 ГЧ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (25°C)

Наименование параметра	Обоз н.	Ед. изм.	мин	тип	макс	Режим измерения
Входное напряжение	Uвх	В	1,1	1,3	1,7	Iвх=12мА
Вых. сопротивление в открытом состоянии	Rотк	Ом		32	35	Iвх=12мА Iвых=30 мА
Ток утечки на вых. в закрытом состоянии	Iут	нА		1,0	5,0	Uвх=0,8В, Uвых=60В
Напряжение изоляции	249КП10АР	Uиз	В		500	t = 5 с
	249КП10БР					
Сопротивление изоляции	Rиз	Ом	10 <sup>10</sup>			Uиз=500 В
Выходная емкость в выключенном состоянии	Cпр	пФ		8	10	Uвых=0В, f = 10 МГц
Время включения	Tвкл	мкс		7	15	Iвх=12мА, Uвых=30В, Rн = 1 кОм, Сн = 25 пФ
Время выключения	Tвык.	мкс		25	35	Iвх=12мА, Uвых=30В, Rн = 1 кОм, Сн = 25 пФ

### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Примечание
Напряжение коммутации	В	-60	60	
Ток коммутации	мА	-50	50	При T ≤ 35°C
Вх. ток во включенном состоянии	мА	12	25	
Вх. импульсный ток	мА		150	Tимп=200мкс
Вх. напряжение в выключенном состоянии	В	-3.5	0.8	
Раб. диапазон температур	°С	-60	125	

### Параметры стойкости

7.И <sub>1</sub>	7.И <sub>6</sub>	7.И <sub>7</sub>	7.С <sub>1</sub>	7.С <sub>4</sub>	7.К <sub>1</sub>	7.К <sub>4</sub>
1,02*1Ус	2,5*2Ус	1,55*1Ус	1,36*1Ус	0,034*1Ус	0,054*1К	0,36*1К

Наработка до отказа Tн при температуре не более (65±5) °С - 100 000 ч, не менее 120 000 ч. в облегченном режиме (Iвх ≤ 15 мА, Iком ≤ 25 мА, Uком ≤ 30 В, (25 ± 10) °С).

Гамма-процентный срок сохраняемости (Tγс) при γ=99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемой влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет.